From : 4hiyo

Power MOS FET 仕様書(暫定)

(シリコンNチャネルエンハンスメントMOS型)

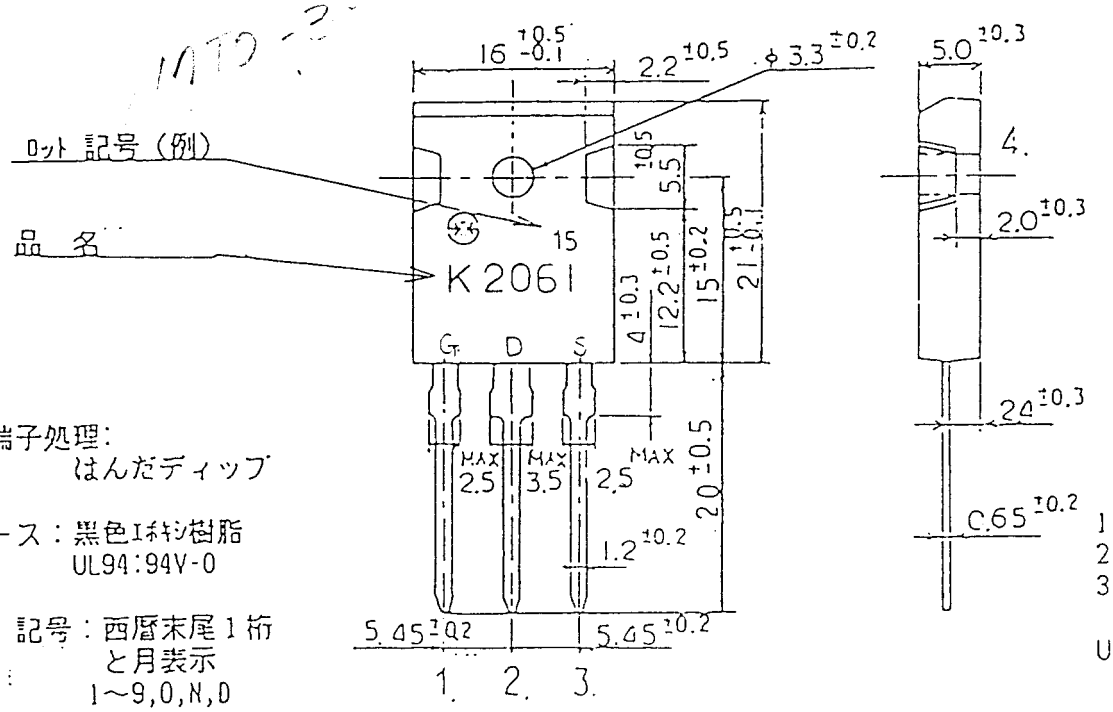
1. 絶対最大定格

項目	記号	条件	規格値	単位
保存温度	T_{stg}		−55〜150	℃
チャネル温度	T_{ch}		150	℃
ドレイン・ソース電圧	V_{DSS}		600	V
ゲート・ソース電圧	V_{GSS}		±30	V
ドレイン電流(直流)	I_D		16	A
(ピーク)	I_{DP}		48	A
ソース電流(直流)	I_S		16	A
全損失	P_T	T_C =25℃	150	W
締め付けトルク	TOR	( ) 内は、推奨値	8 (5)	kg・cm

2. 電気的・熱的特性 T_C =25℃

項目	記号	条件	規格値 MIN	TYP	MAX	単位
ドレイン・ソース降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	I_D =1 mA, V_{GS}= 0 V	600			V
ドレイン遮断電流	I_{DSS}	V_{DS}=600V, V_{GS}= 0 V			250	μA
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	V_{GS}=±30V, V_{DS}= 0 V			±100	nA
順伝達コンダクタンス	g_{fs}	I_D = 8 A, V_{DS}=10 V	6	10		S
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	I_D = 8 A, V_{GS}=10 V		0.45	0.6	Ω
ゲートしきい値電圧	V_{TH}	I_D =1 mA, V_{DS}=10 V	2	3	4	V
ソース・ドレインダイオード順電圧	V_{SD}	I_S = 8 A, V_{GS}= 0 V			1.5	V
熱抵抗	θ_{jc}	接合部・ケース間			0.83	℃/W
入力容量	C_{iss}	V_{DS}=10V, V_{GS}=0V		2500		pF
帰還容量	C_{rss}	f=1MHz		150		pF
出力容量	C_{oss}			575		pF
ターンオン時間	t_{on}	I_D= 8 A, R_L= 19 Ω		130	280	ns
ターンオフ時間	t_{off}	V_{GS}=10V		260	500	ns

3. 外形・寸法



1. ゲート
2.4. ドレイン
3. ソース

Unit:mm

各端子処理:
はんだディップ

ケース:黒色エポキシ樹脂
UL94:94V-0

ロット記号:西暦末尾1桁
と月表示
1〜9,O,N,D

版	年月日	設計	記事
1	H4.8.21	三浜	

新電元工業株式会社

承認 伊藤

検図

客先名 :

品名 : 2SK2061
(F16W60)

図番 :